









	<h2>R6002END3TL1</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: R6002END3TL1</p> <p>Hersteller / Marke: LAPIS Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: NCH 600V 2A POWER MOSFET</p> <p>Datenblätter:  R6002END3TL1.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	R6002END3TL1
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	NCH 600V 2A POWER MOSFET
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 1mA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.4 Ohm @ 500mA, 10V
Verlustleistung (max)	26W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Andere Namen	R6002END3TL1DKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	16 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	65pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6.5nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 1.7A (Tc) 26W (Tc) Surface Mount TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.7A (Tc)

R6002END3TL1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, R6002END3TL1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, R6002END3TL1 LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ R6002END3TL1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>R6002625XXYA Powerex Inc. DIODE GEN PURP 2.6KV 250A DO205</p>	 <p>R60030-1COR Eaton FUSE BLOCK CART 600V 30A CHASSIS</p>	 <p>R6002225XXYA Powerex Inc. DIODE GEN PURP 2.2KV 250A DO205</p>	 <p>R6002030XXYA Powerex Inc. DIODE GEN PURP 2KV 300A DO205</p>
 <p>R6002ENDTL Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1.7A CPT3</p>	 <p>R6002425XXYA Powerex Inc. DIODE GEN PURP 2.4KV 250A DO205</p>	 <p>R60030-1CR Eaton FUSE BLOCK CART 600V 30A CHASSIS</p>	 <p>R60030-1PR Eaton FUSE BLOCK CART 600V 30A CHASSIS</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

R6002END3TL1 LAPIS Semiconductor	R6002END3TL1 Datenblatt	R6002END3TL1-Datenblätter	R6002END3TL1 PDF	LAPIS Semiconductor R6002END3TL1
R6002END3TL1 Electronic	R6002END3TL1-Komponenten	R6002END3TL1-Verteiler	R6002END3TL1-Bild	R6002END3TL1-Teil
R6002END3TL1 Preis	R6002END3TL1 Hersteller	R6002END3TL1 Bild	R6002END3TL1 Aktie	R6002END3TL1 Inventar
R6002END3TL1 Neu	R6002END3TL1 Original	R6002END3TL1 garantiert	R6002END3TL1 RFQ	R6002END3TL1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited